(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 3. Juni 2004 (03.06.2004)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/047194 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 51/40

H01L 51/20,

(74) Anwalt: LOUIS PÖHLAU LOHRENTZ; Postfach 3155,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE2003/003776

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. November 2003 (13.11.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 19. November 2002 (19.11.2002) 102 53 955.3

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von

- US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIX, Walter [DE/DE]; Rötenäckerstr. 7, 90427 Nürnberg (DE). ROST, Henning [DE/DE]; Heinrich-Kirchner-Str. 24, 91056 Erlangen (DE).

- 90014 Nürnberg (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 2. September 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ORGANIC ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING THE SAME ORGANIC MATERIAL FOR AT LEAST TWO FUNCTIONAL LAYERS

(54) Bezeichnung: ORGANISCHES ELEKTRONISCHES BAUELEMENT MIT GLEICHEM ORGANISCHEM MATERIAL FÜR ZUMINDEST ZWEI FUNKTIONSSCHICHTEN

- (57) Abstract: The invention relates to an organic electronic component such as an organic field effect transistor (OFET), in which a single organic material is used for at least two functional layers, for example as a conductive and semiconductive material. The invention also relates to an efficient method for producing two functional layers, for example source and drain electrodes, in addition to the semiconductive layer, in one process step, for use in organic field effect transistors. The conductive or semiconductive regions in the semiconductive or conductive matrix are obtained for example by doping, e.g. by a partially controlled redox reaction.
 - (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung beschreibt ein organisches elektronisches Bauelement wie einen organischen Feld-Effekt-Transistor (OFET), bei dem ein einziges organisches Material für zumindest zwei Funktionsschichten, beispielsweise als leitendes und als halbleitendes Funktionsmaterial, dient. Außerdem beschreibt die Erfindung ein effizientes Verfahren, um in einem Prozessschritt zwei Funktionsschichten, zum Beispiel Source- und Drain Elektroden sowie die Halbleiterschicht für den Einsatz in organischen Feld Effekt Transistoren, zu erzeugen. Die leitenden oder halbleitenden Bereiche in der halbleitenden oder leitenden Matrix werden beispielsweise durch Dotieren, beispielsweise durch eine partiell geführte Redoxreaktion erhalten.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/DE 03/03776

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H01L51/20 H01L51/40

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 - H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

C. DOCUM	INTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to daim No.
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 7 December 1997 (1997-12-07), pages 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 the whole document	1-4
X	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25 November 1997 (1997-11-25) column 5, line 19 - column 6, line 50 -/	1-4,7
X Furt	er documents are listed in the continuation of box C.	in annex.
"A" docume consider	regories of cited documents: Int defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance Into the defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance Into the defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance Into the defining the general state of the art which is not extend to the organization definition of the definiti	n the application but neory underlying the claimed invention of be considered to ocument is taken alone

Y Pulliner documents are instead in the community of sex c.	A 1 a.d. 1 a.d.
Special categories of cited documents: A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E' earlier document but published on or after the International filling date L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the International search report
15 July 2004	22/07/2004
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Königstein, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tional Application No PCT/DE 03/03776

(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
ategory °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Retevant to claim No.
	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 69, no. 1-3, 24 July 1994 (1994-07-24), pages 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779	•	1-4
	the whole document	•	8
	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, vol. 86, no. 1-3, 1997, pages 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 the whole document		8
	XIUYING QIAO ET AL: "The FeC1/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., vol. 122, no. 2, 1 June 2001 (2001-06-01), pages 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 the whole document		
1	KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, vol. 13, no. 21, 2 November 2001 (2001-11-02), pages 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 the whole document		
P,X	WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14 August 2003 (2003-08-14) claims 1-5; figure 6		1-8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

PCT/DE 03/03776

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US 5691089	A	25-11-1997	US US US	5567550 A 5677041 A 5942374 A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999	
WO 03067680	Α	14-08-2003	JP WO	2003234473 A 03067680 A1	22-08-2003 14-08-2003	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L51/20 H01L51/40

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK \ 7 \ H01L$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, PAJ

C.	ALS WES	ENTLICH	AN	SESE ł	HENE (JNTERL	AGEN
----	---------	---------	----	---------------	--------	--------	------

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE LEEUW D M ET AL: "Polymeric integrated circuits and light-emitting diodes" ELECTRON DEVICES MEETING, 1997. TECHNICAL DIGEST., INTERNATIONAL WASHINGTON, DC, USA 7-10 DEC. 1997, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, 7. Dezember 1997 (1997-12-07), Seiten 331-336, XP010265518 ISBN: 0-7803-4100-7 das ganze Dokument	1-4
X	US 5 691 089 A (SMAYLING MICHAEL C) 25. November 1997 (1997-11-25) Spalte 5, Zeile 19 - Spalte 6, Zeile 50 -/	1-4,7

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorten von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T° Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist *X° Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y° Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
15. Juli 2004	22/07/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Königstein, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/DE 03/03776

C./Fortest	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	03/03//6
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DAI L ET AL: "I2-DOPING OF 1,4-POLYDIENES" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 69, Nr. 1-3, 24. Juli 1994 (1994-07-24), Seiten 563-566, XP001051921 ISSN: 0379-6779	1-4
Υ	das ganze Dokument	8
Υ	DAI L ET AL: "CONJUGATION OF POLYDIENES BY OXIDANTS OTHER THAN IODINE" SYNTHETIC METALS, ELSEVIER SEQUOIA, LAUSANNE, CH, Bd. 86, Nr. 1-3, 1997, Seiten 1893-1894, XP001051655 ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	8
A .	XIUYING QIAO ET AL: "The FeCl/sub 3/-doped poly(3-alkyithiophenes) in solid state" SYNTH. MET., Bd. 122, Nr. 2, 1. Juni 2001 (2001-06-01), Seiten 449-454, XP001197314 ELSEVIER, SWITZERLAND ISSN: 0379-6779 das ganze Dokument	
Α	KAWASE T ET AL: "INKJET PRINTED VIA-HOLE INTERCONNECTIONS AND RESISTORS FOR ALL-POLYMER TRANSISTOR CIRCUITS" ADVANCED MATERIALS, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 13, Nr. 21, 2. November 2001 (2001-11-02), Seiten 1601-1605, XP001129628 ISSN: 0935-9648 das ganze Dokument	
P,X	WO 03/067680 A (KUBOTA MAKOTO; CANON KK (JP); KOBAYASHI MOTOKAZU (JP)) 14. August 2003 (2003-08-14) Ansprüche 1-5; Abbildung 6	1-8

IN LENIA INDIALEN NEVITENVITENDENIVIT

Angaben zu Veröffentlik

die zur seiben Patentfamilie gehören

in tionales Aktenzeichen	
PCT/DE 03/03776	

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument				Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung		
US 5691089	A	25-11-1997	US US US	5567550 5677041 5942374	A	22-10-1996 14-10-1997 24-08-1999	
WO 03067680	A	14-08-2003	JP WO	2003234473 03067680		22-08-2003 14-08-2003	